

(74) Si 脱酸反応構造と冷却凝固過程における SiO_2 介在物の生成について東北大學 金属材料研究所 坂上六郎 佐藤圭司
○笹井興士

緒言 溶鉄中ににおける Si 脱酸反応の構造については、すでに報告したように、Si 添加時に SiO_2 生成が完結するようなどとはありえず、一次介在物の浮上がすみやかな場合には、坩堝-溶鉄界面における SiO_2 生成反応によって、溶鉄の脱酸素が律速されることを明らかにした。本報では SiO_2 生成反応構造を明らかにするため、逆反応 $\text{SiO}_2 \rightarrow \text{Si} + 2\text{O}$ の進行を検討し、さらに冷却凝固過程における SiO_2 生成の構造を考察した。

実験方法

- 1560°C の平衡状態から急激に昇温し、1635°C に到達してから以後の酸素增加過程を追跡する。
- 1660°C の平衡状態から 1600°C に降温し、温度低下による脱酸過程を追跡する。
- 1600°C の溶鉄に所定量の Si を添加し、脱酸過程における介在物の挙動を検討する。
- 石英サンプラーに装入してある所定量の Si が溶融したところで、~20 g の溶鉄を採取し、時間保持による SiO_2 粒子の生長を観察する。

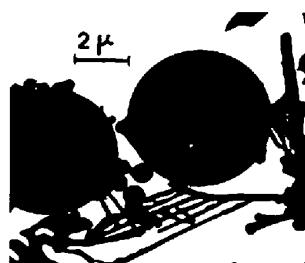
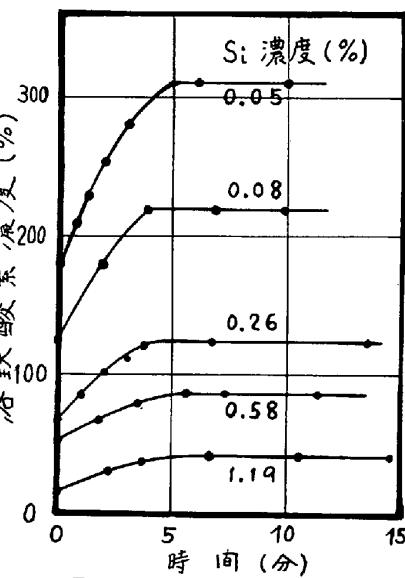
実験結果 A 実験の結果を図 1 に示したが、要約すると

- SiO_2 分解の初期速度は、溶鉄の初酸素濃度とともに増加する傾向がある。
- 初酸素濃度の高い場合には、酸素はほぼ直線的に増加する。
- $\text{Si} > 0.5\%$ では、~6 分で平衡に到達するが、 $\text{Si} < 0.3\%$ の場合には、むしろ短時間になる。

これらのことから、 $\text{SiO}_2 \xrightarrow{k} \text{Si} + 2\text{O}$ の反応速度 v は、 $v = k \cdot [\text{SiO}_2]$ のような単純な形で表はすることはできず、界面に吸着した酸素が、直接反応に関与するようなら、次式のような構造で進行することを暗示している。 $\text{SiO}_2 + \text{O(ad)} \rightarrow \text{Si} + 2\text{O} + \text{O(ad)}$ 吸着酸素と SiO_2 分解速度の関連を、定量的に説明したい。

また B, C 両実験の平衡状態から採取した急冷試料の抽出介在物（すべて二次介在物）には、写真 1 のように、数 μm の球形粒子、樹枝状介在物、図 1. $\text{SiO}_2 \rightleftharpoons \text{Si} + 2\text{O}$ の進行 0.5 μm 以下の微粒子が含まれている。これら三種の介在物はつきのような挙動を示すことがわかった。

- 平衡状態からの採取試料については、Si 濃度の高いほど、また冷却速度の早いとき、球形粒子は小さい。
- 微粒子の大きさは、Si 濃度によつてほとんど変化しない。
- B, C 両実験では、脱酸後平衡に到達するまでの粒子径分布は、ほぼ相似の変化をする。
- 樹枝状介在物は、Si 濃度が低く、冷却速度の早いとき、多量に存在し、かつ太くなる。
- C 実験の脱酸直後を除き、B, C 両実験では保持時間のいかんによらず、つねに樹枝状介在物が認められた。
- D 実験の $\text{Si} > 0.2\%$ の場合には、樹枝状介在物は観察されなかった。

写真 1 抽出介在物に含まれる三種の SiO_2 介在物